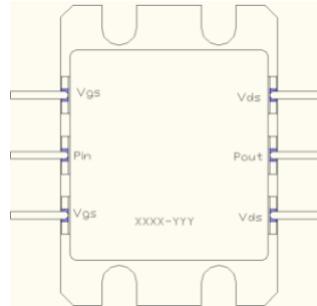


性能特点

- 工作频段: 0.87GHz~1.42GHz
- 输出功率: 55.5dBm (typ.)
- 功率增益: 13dB (typ.)
- 附加效率: 65% (typ.)
- 阻抗匹配: $Z_{in}/Z_{out}=50\Omega$
- 封装形式: QF136GD



产品简介

HXNM42010是一种GaN内匹配宽带功率模块，可工作于连续波模式，在 50Ω 系统中提供最佳功率和增益性能。

最大额定值 ($T_C=+25^\circ\text{C}$)

指标	符号	极限值	单位
漏源电压	V_{DS}	60	V
栅源电压	V_{GS}	-6	V
存储温度	T_{stg}	-65~+175	°C
沟道温度	T_{ch}	225	°C

建议工作条件 ($T_C=+25^\circ\text{C}$)

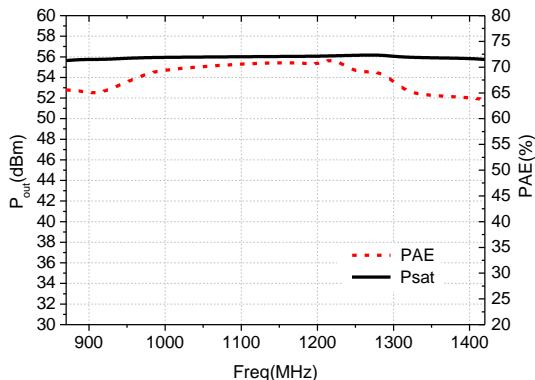
指标	符号	测试条件	极限值	单位
直流输入电压	V_{DS}	48	≤ 32	V
存储温度	T_{stg}	---	-65~+175	°C
沟道温度	T_{ch}	---	175	°C

电参数 ($T_C=+25^\circ\text{C}$)

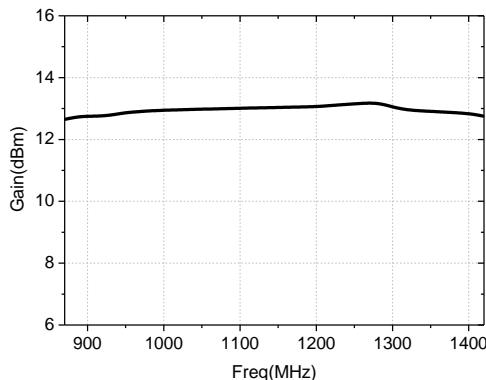
指标	符号	测试条件	极限值			单位
			最小值	典型值	最大值	
饱和输出功率	P_{sat}	$V_{DS}=48\text{V}$ $I_{DS}=0.2\sim 2\text{A}$ $f=0.87\sim 1.42\text{GHz}$, $Z_S=Z_L=50\Omega$	54	55.5	-	dBm
功率增益	G_{sat}		12.5	13	-	dB
附加效率	PAE		60	65	-	%
增益平坦度	ΔG		-		± 1.0	dB

典型曲线

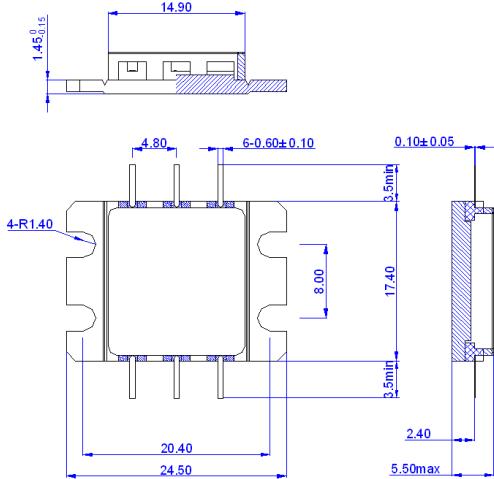
输出功率/效率 vs. 频率



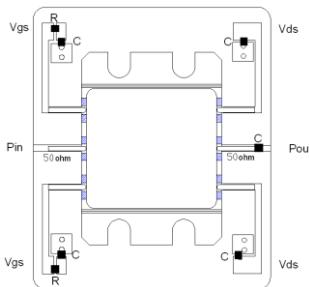
功率增益 vs. 频率



外形尺寸 (单位: mm)



典型使用电路图



注意事项

- 1) 本产品为内匹配型模块，输入输出阻抗为 50Ω ;
- 2) 加电时请严格按先加栅压后加漏压的次序操作;
- 3) 使用过程中注意散热，推荐器件工作壳温不超过 75°C ，过高会导致器件性能恶化，缩短使用寿命;
- 4) 本产品属于静电敏感器件，储存和使用中注意防静电，仪器、设备等应良好接地;
- 5) 不能触摸器件引线;
- 6) 用图示仪测量直流参数时，必须采取防振荡措施，否则易损坏器件，测试结果也不准确;
- 7) 辐照特性：本器件为辐照不敏感产品;
- 8) 有问题请与供货商联系。

